

السلام عليكم ورحمة الله

=====

ردا علي بعض الاستفسارات بخصوص المذاكرة لمنهج تست الالكترونكس  
هجتهد معاكم واحط نفسي مكانكم وكأني انا الطالب الي هيمتحن هفكر ألم ماده ازاي ومنين  
قدر الامكان

١- المصدر الاساسي للمذاكره هي مذكرات التجارب الي نزلت لكم اسبوعيا وعددها ٦  
مذكرات كل مذكوره تحوي فيها عدد من التجارب وبعضها يحتوي علي نظري في اول تجربه ،  
وانا جمعتها في فولدر مع نموذج لامتحان سابق لميديترم وفاينال وايضا بعض النظري من  
مصادر مختلفه من هنا اللينك

<http://www.mediafire.com/download/u558tj6kyzaq5q7/test+theory.rar>

=====

٢- البعض هيقول طب الكلمتين النظري اهم هنقراهم ، طب التجارب نفسها يتسأل فيها  
ازاي وهل هحفظ التجارب بارقام المكونات الي فيهم ؟؟

الاجابه : انت مطالب بفهم الغرض من كل تجربه ورسمتها وفكره عملها ماشيه ازاي  
ووظيفه كل كمبونت فيها لكن مش مطالب تحفظ قيمه كل كمبونت ، هتقولي يعني هحفظ  
الرسمه ؟؟ هقولك ايوه بس دي مبتتحفظش دي بتتفهم لأنه بساطه لما يسألك يقولك  
ارسم دايره بترسم ال characteristics بتاعه ال diode دي مهباش معضله كل الي فيها  
دايود ومقاومه ، ولو لزيتر او LED نفس الديزاين ، ولو ل BJT عندي ٣ انواع من ال  
control .. output ... input .. ch/s ، كل واحده اقدر اعبر عنها بداييره صغيره زي

مثلا ال input عباره عن دايره فيها ترانزستور ومقاومه في ال base متوصل عليها supply ومقاومه ف ال collector وتضع طرفي channel من بتوع ال oscilloscope علي ال Base لقياس او رسم ال IB وطرفي ال channel الاخري بين ال Base و Emitter لقياس VBE والمفترض ان ال Ch/s المتوقعه تكون شبيهه للدايود السليكون وان التيار يمر ويصبح الترانزستور شغال لما فرق الجهد بين اطراف الدخل يصل ل ٠.٧- ٠.٨ فولت ، وهنا العديد من الاسئله زي هو الترانزستور هيكون شبه انهي نوع من انواع ال semiconductor devices طبعا دايود ، ، وهكذا بالنسبه لل output ch/s محتاج اقيس التيار IC كعلاقه مع VCE عند ثبوت قيم IB بالتالي RB هتكون متغيره و بقيس علي اطراف RC وعلي اطراف CE ونفس الحوار في control ch/s لقياس العلاقه بين IC و IB وهيكون نفس دايره ال input ch/s تماما مع تغيير اطراف الاوسليسكوب لتكون علي RC وعلي RB .. ونفس الكلام مع ال FET لقياس نوعين من ال Ch/s فيه هما ال ID & VGS between control ch/s وايضا Output ch/s between ID&VDS at constant values for Vgs

=====

٣ - ممكن السؤال السابق يبجي معكوس ، يعني دايره تجيلك وينطلب منك معرفه بتعمل ايه ، شغاله ازاي ، بتخرج ايه او بترسم ايه ، طب لو شيلنا مكثف من هنا ايه الي يحصل ، طب لو ضفنا مكثف هناك ايه الي يحصل ، طب لو غيرنا قيمه المقاومه الفلانيه ايه الي يحصل ، طب لو عاوز اعدل الدايره بحيث تؤدي وظيفه ثانيه هعمل ايه ؟؟ وهكذا .. بالاضافه للاسئله المباشره زي استخدامات كل كيوننت ايه مثال

Zener =regulator ، LED=indicator ، الخ الخ

=====

٤- بعض الي محتاجين نذاكره بعيدا من وحي العملي زي قيم الجهد الي بتشغل الكمبونت الي عندنا دايدو بانواعه ، ليد ، زينر ، ترانزيستور الخ وايه الشروط لل ON/OFF وايه تطبيقات كل device او كل دايره في الالكترونيا ، وهل ينفع مثلا استخدم ٢ كمبونت شبه بعض مكان بعض ، علي سبيل المثال الدايدو السليكون والزينر في ال Forward متشابهين في ال Ch/s وايضا ال input ch/s of BJT هل ده يدني الحق اني اشغل الزينر او ال BJT مكان الدايدو في دواير ال Rectifier ؟؟ ولو نعم يبقي ليه ولو لا يبقي ليه ؟؟

=====

٥- بعض المعلومات الي محتاجين نرجعلها من منهج الكترونكس اولي زي ما يتعلق بالدايدو وحل مسائله ideal / practical وكذلك BJT وكذلك ال OPAMP

\*\*\*\*\*

وبالطبع العلاقات زي ازاوي تحسب peak / peak to peak / RMS/ average / لأي موجه تجيلك مرسومه او يطلبا منك ترسمها

\*\*\*\*\*

ايضا خرج دواير Half wave rectifier / full wave rectifier ويتحسب ازاوي الخرج بالقوانين  $V_m/\pi$  و  $V_m/\pi^2$  ده لو الدايدو ideal ولو مش ideal هنطرح voltage drop علي الدايدو من ال max value ومعرفته رسمه الخرج في وجود وعدم وجود المكثف وتأثير ال ripples وامتني بيزيد وامتني بيقل

\*\*\*\*\*

مسائل زي استبدال الدايدو بزينر او ليد في دايره ويطلب حساب تيار او جهد

\*\*\*\*\*

مسائل زي حساب ID كداله في Vgs او Vds شبيهه بمنهج الالكترونيات لكن علي  
JFET فقط

\*\*\*\*\*

مسائل زي حساب التيار المار في الزنبر وال load وقيمه الجهد ع ال load في دواير  
line regulation و source regulation

\*\*\*\*\*

ايضا مسائل بسيطه في BJT كالعلاقه بين  $IC = \beta * IB$  وان  $IC + IB = IE$  والعلاقه  
الفا بين IC و IE

ايضا افكار الديزاين لدواير ال opamp زي ازاي

(أ) ازاي تصمم دايره تكبر الموجه الداخله بمقدار الضعف ويكون الخرج في نفس اتجاه  
الدخل in the same phase .. طبعا هنا هيفضل استخدام non inverting amp  
وقانونه  $Vo/Vin = 1 + RF/R1$  ...

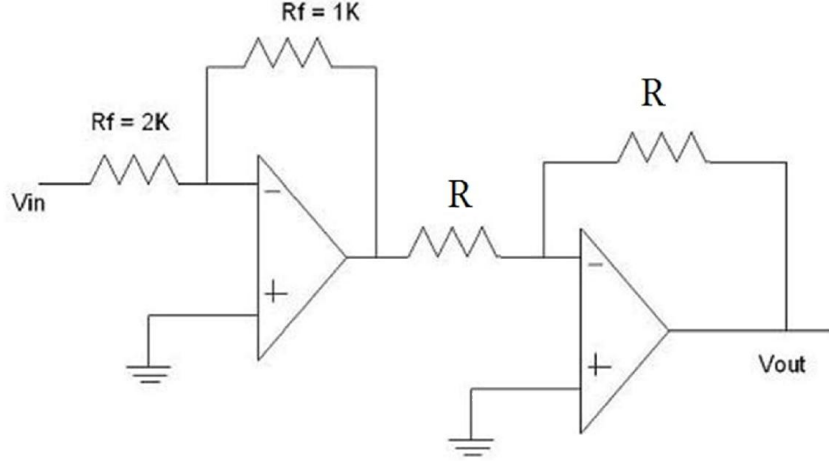
(ب) ازاي تصمم دايره تصغر الموجه الداخله ويبقي الخرج في اتجاه 180 درجه من الدخل  
out of phase وطبعا هنا هنرشح استخدام inverting amp وقانونه  $Vo/Vin = -$   
RF/R1

(ج) ازاي تصمم دايره تصغر الموجه الداخله ويبقي الخرج في نفس اتجاه الدخل وده عمليا  
عشان يحصل لازم يبقي عندي opamp يبصغر وهنا مش هينفع ابدأ noninverting  
علاوه علي حل مشكله ان الخرج يطلع في نفس اتجاه الدخل اي مفيش اشاره سالب ،  
يبقي هحتاج ساعتها 2 دايرتين امبليفير واحده خرجها اقل من 1 وبالسالب inverting  
والتانيه خرجها 1- وبرزه inverting وبتكون المحصله الكليه حينها حاصل ضرب ال  
gain في الدايرتين .....مرفق تحت صوره لفكره الديزاين

واسئله من هذا القبيل كثير كلها بالقوانين

امثله اخري هنا :

<http://www.technologystudent.com/elec1/opamp2.htm>



=====

٦- اسئله زي الاجزاء النظري او الاختيارات او اكمل الي بتبقي اثناء التجربه العملي موجوده وسط الاسئله والمفروض بتحلوها او بتحسبوها اثناء اجراء التجربه ومرفق لكم صور متصوره بالموبايل من حل الكتاب ( المانيوال )

[https://docs.google.com/file/d/0B6Hu\\_WMR0Zc0TEVPcHY2UnJXQWM/edit?usp=doclist\\_api](https://docs.google.com/file/d/0B6Hu_WMR0Zc0TEVPcHY2UnJXQWM/edit?usp=doclist_api)

=====

٧- تيجي الاسئله بشكل غير مباشر ، يعني صمم دايره 12V power supply باستخدام المكونات الي انت درستها ف منهج التست بتاعك ، ، اكيد هتستعين ب full wave rectifier + capacitive filter + zener as a regulator

او زي مثلا صمم دايره تعمل الوظيفه الفلانيه ( وظيفه من الوظائف المتعلقة بال  
semiconductor devices الي عندك )

=====

٨- اثبات زي الاثبات بتاع ال opamp بنوعيه وموجود في الملف المرفوع فوق ف  
البوست تحت بند افكار خارجيه ،،، ايضا النظري الخاص زي خواص ال opamp  
وزي المقارنه بين FET و BJT .

=====

ارجو ان تكون الامثله الي اوضحتها لكم نورت بعض الشئ الطريق الي محسني انه  
مظلم ، واتمني لكم جميعا التوفيق